



## 科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	FinFET器件及其制作方法
专利类别:	国际专利
申请号:	PCT/CN2013/080887
申请日期:	2013-08-06
专利号:	9,391,073
第一发明人:	殷华湘;马小龙;徐唯佳;徐秋霞;朱慧琰
实施情况:	授权
专利证书号:	9,391,073
其它备注:	十室

